

Один из ведущих физиков страны, член-корр РАН, заместитель председателя СПБО РАН, директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Сергей Викторович Иванов отмечает 65-летний юбилей

24.06.2025

Один из ведущих физиков страны, член-корр РАН, заместитель председателя СПБО РАН, директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Сергей Викторович Иванов отмечает 65-летний юбилей.



Сергей Викторович — доктор физико-математических наук, профессор, один из ведущих экспертов в мире в области технологии молекулярно-пучковой эпитаксии и физики полупроводниковых наногетероструктур, член Президиума и глава Объединённого научного совета по естественным наукам СПБО РАН.

Более 40 лет жизни ученого связаны с Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН, куда он пришел в 1983 году после окончания с отличием факультета электронной техники Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ). Сергей Викторович прошел

путь от стажёра-исследователя до заведующего лабораторией квантово-размерных гетероструктур и группой молекулярно-пучковой эпитаксии. В 1989 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году — докторскую. С 2019 года он возглавляет ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН.

Начинал свою научную деятельность С. В. Иванов под руководством гениального физика, Нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алферова, которого по праву считает своим учителем. Спустя четыре десятилетия он был удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга имени Алферова за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в номинации нанотехнологии.

Среди важнейших научных достижений Иванова — создание эффективных наногетероструктур для полупроводниковой оптоэлектроники и квантовой фотоники широкого спектрального диапазона.

С. В. Иванов блестяще совмещает руководящую, исследовательскую и преподавательскую деятельность. Он читает курсы по молекулярно-лучевой эпитаксии студентам Алферовского института (СПбАУ РАН) и своей альма-матер (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), в которых подготовил 7 кандидатов наук. Сергей Викторович сотрудничает с российскими и зарубежными университетами, научными центрами, принимает активное участие в конференциях и симпозиумах.

Автор свыше 800 опубликованных научных работ, 10 глав в монографиях и 9 патентов, более 350 публикаций в журналах, в том числе в возглавляемом им издании «Физика и техника полупроводников». Индекс Хирша — 39.

Исследовательская деятельность учёного отмечена благодарностями Президента РАН и губернатора Санкт-Петербурга, медалью Минобрнауки РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области технологического развития», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президиум Санкт-Петербургского отделения РАН поздравляет юбиляра и желает здоровья, новых достижений и открытий на благо отечественной науки.

